

# 2SA993

シリコン PNP エピタキシャル形

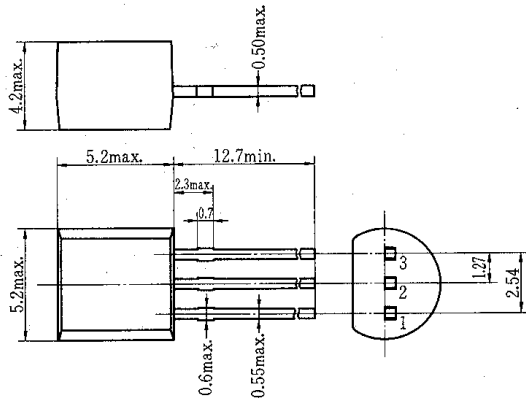
低周波増幅用

2SC2277とコンプリメンタリペア

SILICON PNP EPITAXIAL

LOW FREQUENCY AMPLIFIER

Complementary pair with 2SC2277



1. エミッタ: Emitter
2. ベース: Base
3. コレクタ: Collector

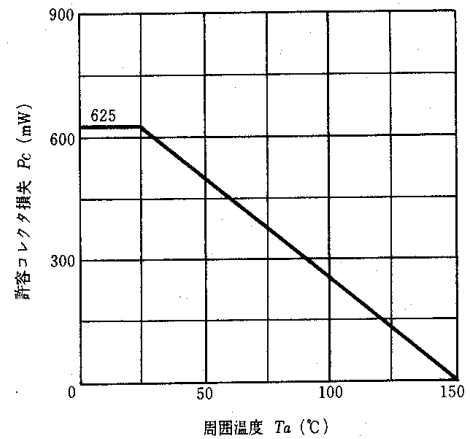
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-92)

## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SA993	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	-50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	-50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-500	mA
許容コレクタ損失	$P_C$	625	mW
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$	-50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = -1\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$	-5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -50\text{V}, I_E = 0$	—	—	-100	nA
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE} = -3\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	60	—	320	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	—	—	-0.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -150\text{mA}, I_B = -15\text{mA}$	—	—	-0.5	V

\* 2SA993は $h_{FE}$ の値により3区分し、現品に表示してあります。

\* The 2SA993 is grouped by  $h_{FE}$  as follows.

Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60~120	100~200	160~320